
	<h2 style="color: red;">FQD4P25TM</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD4P25TM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD4P25TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD4P25TM.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 31675 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD4P25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	31675 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 3.1A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 Ohm @ 1.55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD4P25TM ist neu im Original, Suche FQD4P25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4P25TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD4P25TM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD4P40</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p><b>FQD4P25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD4N65C</b> VB FQD4N65C VB</p>
 <p><b>FQD4P40TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A DPAK</p>	 <p><b>FQD4P25TM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD4P25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD4P25TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ FQD3N60TM</li> <li>⊕ FQD3P50TM</li> <li>⊗ FQD4N20TF</li> <li>D FQD4N25TM</li> <li>⇒ FQD4N50TM</li> <li>⊕ FQD4P25TM</li> <li>⊗ FQD5N20L</li> <li>⊕ FQD5N40TM</li> <li>⊗ FQD5N50CTM</li> <li>⊕ FQD5N60C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ FQD3P20TF</li> <li>⊗ FQD3P50TM</li> <li>⊕ FQD4N20TF</li> <li>⊗ FQD4N50S</li> <li>⇒ FQD4N50TM</li> <li>⇒ FQD5N15TF</li> <li>D FQD5N20LTM</li> <li>⊗ FQD5N40TM</li> <li>⊕ FQD5N50CTM</li> <li>⊗ FQD5N60CTF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ FQD3P20TF</li> <li>D FQD4N20L</li> <li>⊗ FQD4N20TM</li> <li>⊕ FQD4N50T</li> <li>⊗ FQD4N60C</li> <li>D FQD5N15TF</li> <li>⇒ FQD5N20LTM</li> <li>⇒ FQD5N50C</li> <li>⊗ FQD5N50CTM-NL</li> <li>⊕ FQD5N60CTF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D FQD3P50TF</li> <li>⇒ FQD4N20LTF</li> <li>⇒ FQD4N20TM</li> <li>⊗ FQD4N50TF</li> <li>⊕ FQD4N60CTM</li> <li>⊗ FQD5N15TM</li> <li>⇒ FQD5N20TF</li> <li>⇒ FQD5N50CTF</li> <li>D FQD5N50TF</li> <li>⊗ FQD5N60CTM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ FQD3P50TF</li> <li>⇒ FQD4N20LTF</li> <li>⇒ FQD4N25TM</li> <li>⇒ FQD4N50TF</li> <li>⇒ FQD4N65C</li> <li>⊕ FQD5N15TM</li> <li>⇒ FQD5N20TF</li> <li>⇒ FQD5N50CTF</li> <li>⇒ FQD5N50TF</li> <li>⇒ FQD5N60CTM</li> </ul>
---	--	--	--	--

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited